

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 112年度上字第603號

03 上 訴 人 友威科技股份有限公司

04 代 表 人 李原吉

05 訴訟代理人 趙嘉文 專利師

06 吳俊億 專利師

07 楊理安 律師

08 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

09 代 表 人 廖承威

10 參 加 人 凌嘉科技股份有限公司

11 代 表 人 陳連春

12 訴訟代理人 陳冠宏 律師

13 蔣昕佑 律師

14 陳豫宛 專利師

15 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年2月  
16 23日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第49號行政判決，提  
17 起上訴，本院判決如下：

18 主 文

19 一、上訴駁回。

20 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

21 理 由

01 一、本件於民國112年2月15日修正公布智慧財產案件審理法施行  
02 前已繫屬於法院，依智慧財產案件審理法第75條第3項規  
03 定，應依修正施行前智慧財產案件審理法(下稱修正前智慧  
04 財產案件審理法)規定審理。

05 二、參加人前於103年12月25日以「多層膜的量產方法」向被上  
06 訴人申請發明專利，經審查後准予專利，發給發明第000000  
07 0號專利證書(下稱系爭專利)。嗣上訴人以系爭專利違反核  
08 准時專利法第22條第2項規定，對之提起舉發，經被上訴人  
09 以111年3月4日(111)智專三(五)01146字第11120221170  
10 號專利舉發審定書為「請求項1至10舉發不成立」之處分。  
11 上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明撤銷原處分及訴願決  
12 定，被上訴人就系爭專利舉發事件，應作成「請求項1至10  
13 舉發成立，應予撤銷」之審定。經原審判決駁回，提起本件  
14 上訴。

15 三、上訴人起訴主張及被上訴人與參加人於原審之答辯，均引用  
16 原判決之記載。

17 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)證據6並未  
18 揭示或教示系爭專利請求項1所界定之技術特徵1F及1G，發  
19 明所屬技術領域中具有通常知識者亦無動機將證據6所揭示  
20 雙面覆膜運作步驟進行簡單變更而完成系爭專利請求項1之  
21 發明的整體，且該等技術特徵所達成之提高鍍膜生產線利用  
22 率等功效，亦非基於證據6而可預期者，是以，證據6不足以  
23 證明系爭專利請求項1不具進步性。(二)證據5至7及甲證3之任  
24 一者均至少未揭示或教示系爭專利請求項1所界定之技術特  
25 徵1F及1G，且發明所屬技術領域中具有通常知識者並無合理  
26 動機結合證據5至7及甲證3，縱使勉強結合該等證據，亦無  
27 從恣意擷取並拼湊裝置部件，遑論思及採用特定之複數載具  
28 的載入及相對移動過程，完成系爭專利請求項1之發明整  
29 體，況該等技術特徵所達成之提高鍍膜生產線利用率等功  
30 效，並非基於證據5至7及甲證3而可預期者，是以，證據5至  
31 7及甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

01 (三)證據8雖揭示3個濺鍍腔室，但仍至少未揭示或教示系爭專  
02 利請求項1所界定之技術特徵1F及1G，是證據5至8及甲證3之  
03 組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，自亦不足以  
04 證明依附於請求項1之請求項2至9不具進步性。(四)證據9雖揭  
05 示自動回流單元，但仍未揭示或教示系爭專利請求項1所界  
06 定之技術特徵1F及1G，證據5至9及甲證3之組合不足以證明  
07 系爭專利請求項1不具進步性，自亦不足以證明依附於請求  
08 項1之請求項10不具進步性。(五)被上訴人以系爭專利請求項1  
09 至10未違反核准時專利法第22條第2項規定，為舉發不成立  
10 之原處分，其理由雖有不同，惟結論並無二致，仍應予維  
11 持，則訴願決定維持原處分，亦無違誤等語，駁回上訴人在  
12 原審之訴。

13 五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：

14 (一)按發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。  
15 專利法第71條第3項本文有明文規定。系爭專利之核准審定  
16 日為104年10月30日，是系爭專利有無撤銷之原因，自應以  
17 其核准時專利法為斷。再按發明如為其所屬技術領域中具有  
18 通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得  
19 發明專利，核准時專利法第22條第2項定有明文。進步性之  
20 判斷應以申請專利之發明整體為對象，若該發明所屬技術領  
21 域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基礎，利用  
22 申請時之通常知識，即能預期得到該發明者，則該發明之整  
23 體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者即屬能被輕易  
24 完成，而不具進步性。又取捨證據、認定事實屬於事實審法  
25 院之職權。若其取證、認事並不違背法令及經驗、論理或證  
26 據法則，即不許任意指摘其採證或認定不當，以為上訴理  
27 由。

28 (二)習知多層膜在量產過程中，為均勻地鍍製出該等多層膜，該  
29 等待鍍物於各鍍膜區間執行各鍍膜製程時需分別於各鍍膜  
30 區間的靶材下方位移多次。然而，由於各鍍膜區間之靶材  
31 下方位置處是屬於一電漿區，該等待鍍物將因長時間暴露在

01 各電漿區而衍生出過熱問題。再者，上述鍍膜生產線也礙於  
02 該量產設備的限制，該載具只能令該整批待鍍物中的單一個  
03 待鍍物在完成每一鍍膜區間的鍍膜製程以產生其完成品後，  
04 才能再重新載放下一個待鍍物。因此，導致未執行鍍膜製程  
05 的鍍膜區間閒置，並造成量產效率不彰且提高時間成本的困  
06 擾。系爭專利發明之目的，即在提供一種多層膜的量產方  
07 法，利用該鍍膜生產線之依序輪流配置的緩衝區間與鍍膜區  
08 間，並配合該等載具同時進入相對應的各鍍膜區間內執行各  
09 道鍍膜程序時，是於各鍍膜區間之兩相鄰緩衝區間位移，使  
10 各鍍膜區間內是同時執行各道鍍膜程序且未呈現出閒置狀  
11 態，以有效地利用各鍍膜區間並提高鍍膜生產線的利用率，  
12 進而提高產能(見系爭專利說明書段落[0003]、[0004]、[00  
13 13])。系爭專利申請專利範圍共計10項，其中請求項1為獨  
14 立項，其餘均為附屬項，原審經比對系爭專利請求項與證據  
15 5至9、甲證3，就證據6或證據5至7及甲證3之組合不足以證  
16 明系爭專利請求項1不具進步性、證據5至8及甲證3之組合不  
17 足以證明系爭專利請求項2至9不具進步性、證據5至9及甲證  
18 3之組合不足以證明系爭專利請求項10不具進步性等情，業  
19 已明確論述其認定之依據及得心證之理由，經核於法並無不  
20 合，且無違反經驗法則、論理法則或證據法則，亦無判決不  
21 備理由或理由矛盾情事。

22 (三)系爭專利請求項1所界定之技術特徵為：

23 技術特徵1A：「一種多層膜的量產方法」

24 技術特徵1B：「是用以將多數待鍍物進行多道鍍膜程序，其  
25 包含以下步驟：」

26 技術特徵1C：「一步驟(a)，提供一具有(n+1)個緩衝區間、  
27 n個鍍膜區間與多個載具的鍍膜生產線，該等  
28 緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序  
29 輪流設置於一真空腔體內， $n \geq 2$ 且是正整數；

30 」

31 技術特徵1D：「一步驟(b)，於該鍍膜生產線的第一個緩衝

01 區間或第二個緩衝區間載入放置有第一個待鍍  
02 物的第一個載具；」

03 技術特徵1E：「一步驟(c)，於該步驟(b)後，令第一個載具  
04 於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序以於第  
05 一個待鍍物上形成一第一膜層時，是於該第一  
06 一、二個緩衝區間兩者間位移至少一次；」

07 技術特徵1F：「一步驟(d)，於該步驟(c)後，令第一個載具  
08 位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，且同  
09 時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個  
10 緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載  
11 具，但有條件的是，當第二個載具位於第二個  
12 緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區  
13 間；及」

14 技術特徵1G：「一步驟(e)，於該步驟(d)後，同時令第二個  
15 載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第  
16 二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道  
17 鍍膜程序，以分別於第二個待鍍物上與第一個  
18 待鍍物之上形成該第一膜層與一第二膜層時，  
19 是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第  
20 二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，但有  
21 條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間  
22 時，第一個載具是位於第三個緩衝區間。」

23 證據6為一種適用於被動元件之雙面覆膜設備，待鍍物於製  
24 程腔體內即可完成被動元件之雙面覆膜之製程，精簡了被動  
25 元件之雙面覆膜之製程週期，降低了製程之複雜度以及成  
26 本，另更可維持製程腔體內之低壓之一致性(見證據6說明書  
27 摘要欄)。證據6說明書段落[0041]、[0042]記載「本創作無  
28 需反覆地進行回復至常壓動作、抽氣至低壓動作或加熱動  
29 作，進一步精簡了被動元件之雙面覆膜之製程週期……」、  
30 「進行被動元件之雙面覆膜之製程時，可維持製程腔體內之  
31 低壓之一致性，待鍍物之雙面覆膜層不易產生彼此之膜特徵

01 相異之情形。」可知證據6之目的在維持製程低壓的一致性，  
02 不需反覆進行抽氣，是原審以證據6進行鍍膜程序時，  
03 應會使該等待鍍物整批次輸送至第一緩衝空間41，關閉第一  
04 低壓腔體與製程腔體之間的閘門後，再進行待鍍物於製程腔  
05 體內的輸送及沉積製程，亦即製程期間前述閘門應保持關閉  
06 以維持製程腔體內之低壓一致性，進而認定證據6並未揭示  
07 系爭專利請求項1所述步驟(d)技術特徵(即技術特徵1F)，並  
08 無不合。再按證據6圖5雖揭露多個待鍍物，然全篇並未揭示  
09 或教示多個待鍍物於雙面覆膜設備中應如何作動或相對移  
10 動，是該多個待鍍物之移動方式自有多種不同態樣，原審因  
11 認證據6並未揭示系爭專利請求項1所述步驟(e)技術特徵  
12 (即技術特徵1G)，亦無違誤。至系爭專利是否需如證據6維  
13 持其腔體的低溫狀態，並非系爭專利之技術內容，難認原判  
14 決之認定有理由矛盾可言。又兩造及參加人於原審已就證據  
15 6待鍍物作動方式是否揭露系爭專利請求項1技術特徵1F、1  
16 G，系爭專利請求項1是否為所屬技術領域中具通常知識者依  
17 證據6所能輕易完成為爭執，並經充分攻防及辯論，原審綜  
18 合全辯論意旨及調查證據結果，認定證據6未揭露系爭專利  
19 請求項1技術特徵1F、1G，進而認定證據6不足以證明系爭專  
20 利請求項1不具進步性，自無構成突襲性裁判可言。上訴意  
21 旨主張原審就證據6需整批待鍍物同時進入閘門之推論並無  
22 證據支持，且構成突襲，又若該推論成立，系爭專利同樣也  
23 無法執行要件1F技術特徵，另原審錯誤推論證據6有多種排  
24 列組合而認無法輕易完成，復未曉諭兩造辯論，有判決不備  
25 理由、理由矛盾及判決未適用法規之違法云云，自無足取。

26 (四)進步性之判斷涉及複數引證技術內容之結合時，應考量該所  
27 屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之  
28 技術內容而完成該發明。而是否有動機能結合複數引證，則  
29 應綜合考量技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功  
30 能或作用之共通性及教示或建議等事項。所謂所欲解決問題  
31 之共通性，係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之所

01 欲解決問題予以判斷。判斷某一引證之技術內容的所欲解決  
02 問題，得就該引證中記載之所欲解決問題，或該發明所屬技  
03 術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題等進行  
04 考量。所謂功能或作用之共通性，係以複數引證之技術內容  
05 是否包含實質相同之功能或作用予以判斷。若複數引證之技  
06 術內容的功能或作用具有共通性，則可認定該發明所屬技術  
07 領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。  
08 系爭專利請求項1係利用依序輪流配置的緩衝區間與鍍膜區  
09 間，配合複數載具同時進入相對應的各鍍膜區間內執行各道  
10 鍍膜程序時，於各鍍膜區間之兩相鄰緩衝區間位移，以有效  
11 地利用各鍍膜區間並提高鍍膜生產線的利用率，然證據5至7  
12 及甲證3均未敘及使多個待鍍物同時進入相對應的鍍膜區間  
13 同時執行各道鍍膜程序，以提高鍍膜生產線利用率之目的。  
14 又證據5係使基板往復通過單一濺射腔室而於其單面進行多  
15 道鍍膜程序，證據6係先通過一沉積空間以於待鍍物之一面  
16 覆膜、再通過另一沉積空間以於待鍍物之另一面覆膜，證據  
17 7乃使基材通過複數處理腔室且每一處理腔室均對基材之兩  
18 側面同時進行鍍膜，甲證3則係使基板直列式通過多個沉積  
19 腔而於其單面進行多道鍍膜程序，顯見該等證據之鍍覆型態  
20 各異，所欲解決之問題與功能、作用難謂有共通性，各證據  
21 中亦無明確記載或實質隱含結合不同證據之技術內容的教示  
22 或建議，發明所屬技術領域中具有通常知識者難謂有動機結  
23 合證據5至7及甲證3。縱使勉強結合該等證據，由於證據5至  
24 7及甲證3所記載之沉積/鍍膜裝置皆係基於不同鍍覆型態所  
25 設計者，仍無從恣意擷取並拼湊裝置部件，更不必論及特定  
26 採用如系爭專利請求項1所述多層膜的量產方法，是證據5至  
27 7及甲證3不具結合動機等情，業據原審詳述其認定之依據及  
28 得心證之理由，原審亦就上訴人主張何以不足採取，論明：  
29 證據7圖2僅為靜態圖，上訴人逕稱使該圖的2個載具同步移  
30 動是最直覺、最直觀的判斷，實有後見之明；系爭專利請求  
31 項1相較於證據7之差異並非僅在閘門之有無，證據7未具體

01 揭示多個待鍍物之相對移動過程，且即便結合證據7與證據  
02 5、6及甲證3，發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無從  
03 特定採用如系爭專利請求項1所述多層膜的量產方法（特別  
04 是步驟(d)至(e)所述之複數載具的載入及相對移動過程），  
05 更無從預期提高鍍膜生產線利用率等功效，因此仍無助於否  
06 定系爭專利請求項1之進步性等語，依前開說明，經核於法  
07 並無不合，亦無判決不備理由情事。上訴意旨主張原審僅因  
08 證據5至7及甲證3各自鍍膜程序細節不同即認無結合動機，  
09 忽略證據7已足使通常知識者理解「可同步移動」之特徵，  
10 並可自證據6、7之內容輕易完成系爭專利請求項1，且原審  
11 未憑證據推論閘門會對待鍍物產生過熱問題有一定助益，有  
12 適用法規不當、判決不備理由之違法云云，核係就其於原審  
13 提出而為原判決所不採之主張，復執陳詞為爭議，並就原審  
14 認定事實、取捨證據之職權行使，及與判決結果無礙之理  
15 由，指摘原判決不當，並不可採。

16 (五)綜上所述，原判決駁回上訴人於原審之訴，並無違誤。上訴  
17 論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理  
18 由，應予駁回。

19 六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理  
20 法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判  
21 決如主文。

22 中 華 民 國 114 年 4 月 10 日

23 最高行政法院第二庭

24 審判長法官 陳 國 成

25 法官 簡 慧 娟

26 法官 高 愈 杰

27 法官 林 麗 真

28 法官 蔡 如 琪

29 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

30 中 華 民 國 114 年 4 月 10 日

